



圖 13-56 元件模型用於設計流程中 Transistor level，模擬電路實際運行效能。

一般而言，電晶體的電路模型研究的領域大致上分為三種，一類是在固定偏壓及元件尺寸大小下所使用的特殊模型，由於在較高頻下做探討，一般稱之為小訊號模型（Small-Signal Model）；而另一類是所謂查表法的模型（Look-up Table model），它需要有大量的元件及資料庫才能夠使用，此種模型效率極低；最後一類是實際的物理模型（Physical Compact Model），藉由量測得到的物理現象與電氣特性，並且將各種可能會發生的物理效應考慮在電路模型之